

芯片规格书





芯片规格书

YND001B是一款KU波段幅相多功能芯片。芯片基于0.15um砷化镓工艺。包含六位移相,六位衰减,收发切换开关和放大器。其外形尺寸和端口如图1所示,端口定义如表1所示。本芯片与串并转换芯片RS8163配合使用。

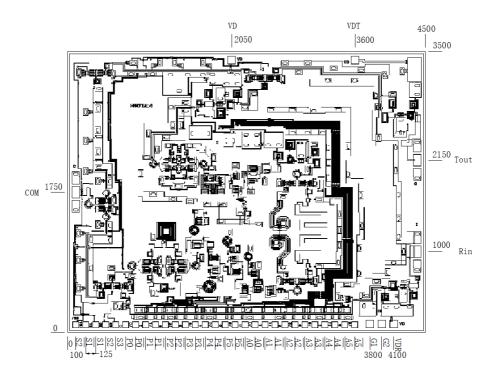


图1 芯片外形接口示意图



芯片规格书

接口定义:

端口名称	端口定义	说明
СОМ	公共端口	发射输入/接收输出
T _{out}	发射输出端口	发射输出,内置隔直电容
R _{IN}	接收输入端口	接收输入,内置隔直电容
VD	公共支路供电端口	5V
VDT	发射漏极供电	5V
VDR	接收漏极供电	5V
G1	接收增益调节端口1	1dB增益调节,空置衰减,接-5V直通
G2	接收增益调节端口2	1dB增益调节,空置衰减,接-5V直通
S1	接收开关控制端口	0V接收支路导通-5V关断
51	接收开关反向控制端口	-5V接收支路导通0V关断
S2	发射开关控制端口	0V发射支路导通-5V关断
32	发射开关反向控制端口	-5V发射支路导通0V关断
S3	负载态开关控制端口	0V切负载态-5V关断
P0	5.625度移相控制端口	0V移相态-5V基态
PU	5.625度移相反向控制端口	-5V移相态0V基态
P1	11.25度移相控制端口	0V移相态-5V基态
PI	11.25度移相反向控制端口	-5V移相态0V基态
P2	22.5度移相控制端口	0V移相态-5V基态
PZ	22.5度移相反向控制端口	-5V移相态0V基态



芯片规格书

端口名称	端口定义	说明
P3	45度移相控制端口	0V移相态-5V基态
FS	45度移相反向控制端口	-5V移相态0V基态
P4	90度移相控制端口	0V移相态-5V基态
Γ4	90度移相反向控制端口	-5V移相态0V基态
P5	180度移相控制端口	0V移相态-5V基态
FO	180度移相反向控制端口	-5V移相态0V基态
A0	0.5dB衰减控制端口	0V衰减态-5V基态
Au	0.5dB衰减反向控制端口	-5V衰减态0V基态
A1	1dB衰减控制端口	0V衰减态-5V基态
A1	1dB衰减反向控制端口	-5V衰减态0V基态
A2	2dB衰减控制端口	0V衰减态-5V基态
AZ	2dB衰减反向控制端口	-5V衰减态0V基态
A3	4dB衰减控制端口	0V衰减态-5V基态
AS	4dB衰减反向控制端口	-5V衰减态0V基态
A4	8dB衰减控制端口	0V衰减态-5V基态
	8dB衰减反向控制端口	-5V衰减态0V基态
A5	16dB衰减控制端口	0V衰减态-5V基态
AJ	16dB衰减反向控制端口	-5V衰减态0V基态

表1端口说明



芯片规格书

极限参数:

端口名称	工作电压	极限参数
VD/VDT/VDR	+5V	+6V
控制端口	-5V/0V	-8V/1V
射频端口		Pin<17dBm

表2极限参数

真值表:

	S	1	S2		S 3	VD	VDT	VDR
发射态	-5V	0V	0V	-5V	-5V	5V	5V	0V
接收态	0V	-5V	-5V	0V	-5V	5V	0V	5V
负载态	-5V	0V	-5V	0V	0V	0V	0V	0V

表3 收发真值表

	P0	P0	P1	<u>P1</u>	P2	P2	Р3	P3	P4	<u>P4</u>	P5	<u>P4</u>
5.625°	0V	-5V	-5V	0V	-5V	0V	-5V	0V	-5V	0V	-5V	0V
11.25°	-5V	0V	0V	-5V	-5V	0V	-5V	0V	-5V	0V	-5V	0V
22.5°	-5V	0V	-5V	0V	0V	-5V	-5V	0V	-5V	0V	-5V	0V
45°	-5V	0V	-5V	0V	-5V	0V	0V	-5V	-5V	0V	-5V	0V
90°	-5V	0V	-5V	0V	-5V	0V	-5V	0V	0V	-5V	-5V	0V
180°	-5V	0V	-5V	0V	-5V	0V	-5V	0V	-5V	0V	0V	-5V

表4移相态真值表



芯片规格书

	Α0	A0	A1	A1	A2	A2	А3	A3	A4	A4	A5	A5
0.5dB	0V	-5V	-5V	0V	-5V	0V	-5V	0V	-5V	0V	-5V	0V
1dB	-5V	0V	0V	-5V	-5V	0V	-5V	0V	-5V	0V	-5V	0V
2dB	-5V	0V	-5V	0V	0V	-5V	-5V	0V	-5V	0V	-5V	0V
4dB	-5V	0V	-5V	0V	-5V	0V	0V	-5V	-5V	0V	-5V	0V
8dB	-5V	0V	-5V	0V	-5V	0V	-5V	0V	0V	-5V	-5V	0V
16dB	-5V	0V	0V	-5V								

表5 衰减态真值表

电性能:

主要性能参数如表6所示。

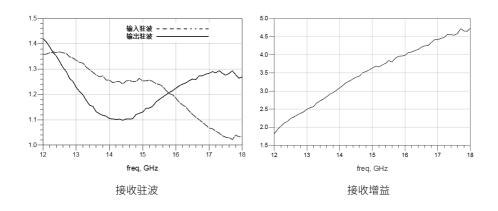
工作频率	F	14-18GHz
发射增益	G_{T}	4dB
发射增益平坦度	$\triangle G_{T}$	±1dB
VDT工作电流	I _{DT}	<40mA
发射P1dB	P _{-1T}	15dBm
发射态输入驻波	VSWR _{i-t}	1.7
发射态输出驻波	VSWR _{o-t}	1.8
接收增益	G _R	2dB
接收增益平坦度	$\triangle G_{R}$	±1dB
VDR工作电流	I _{RT}	<40mA



芯片规格书

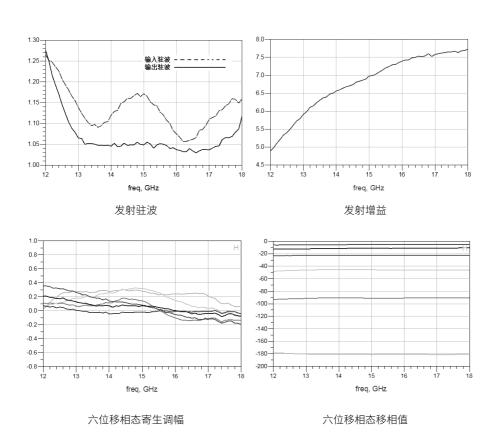
接收P1dB	P-1R	11dBm
接收态输入驻波	VSWR _{i-R}	1.7
接收态输出驻波	VSWR _{o-R}	1.7
VD工作电流	ID	<60mA
移相位数		6位,5.625°
移相RMS		3°
移相附加调幅		±1dB
衰减位数		6位, 0.5dB
衰减RMS		0.5dB
衰减附加相移		±5°

表6性能参数



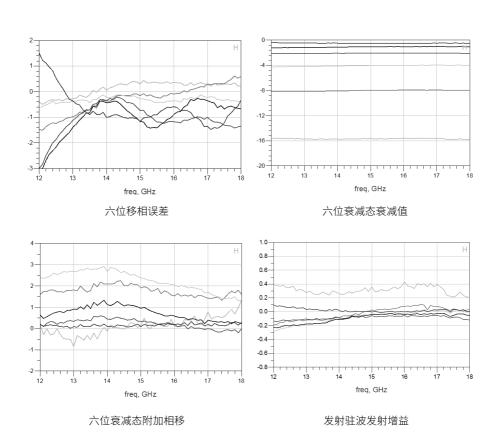


芯片规格书





芯片规格书





芯片规格书

装配说明:

装配图如图2所示。RS8163接口定义请参照相关文档。

